

单位: mil

LPVBG29A

产品特性:

尺寸
芯片尺寸: 15mil x 29mil
(360±20μm x 725±20μm)

芯片厚度: 4.0mil(100±10μm)
焊盘尺寸: 3.1mil(78±10μm)

焊盘金属

P焊盘: 金

N焊盘: 金



LatticePower

产品介绍

Product Introduction

LPVBG29A



LatticePower

产品介绍

Product Introduction

LPVBG29A

最大额定值

DC 正向电流	150mA
正向峰值电流(1/10占空比@1kHz)	240mA
LED结温	115℃
反向电压	5V
使用温度范围	-40 ~ 85℃
贮存温度范围	0 ~ 40℃

说明:

- 1.最大额定值为晶能光电封装条件下测试得到, 不同封装形式得到的值会有所不同, 建议在不超过最大额定值的条件下使用, 超过最大额定值使用可能会引起LED芯片毁坏。
- 2.本产品非设计与逆向电流(压)下使用, 不建议在任何逆向电流(压)下使用。

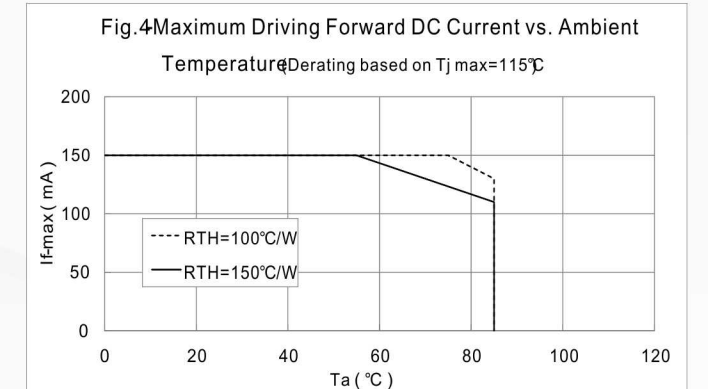
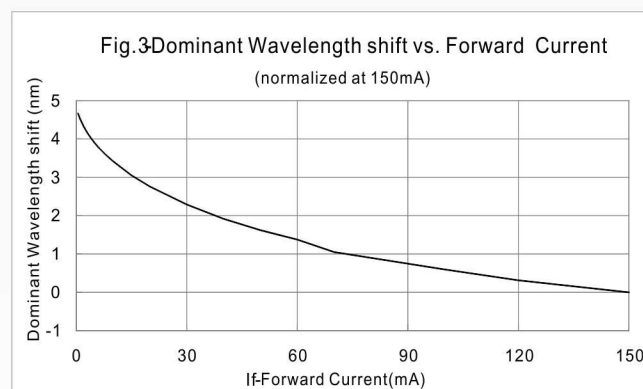
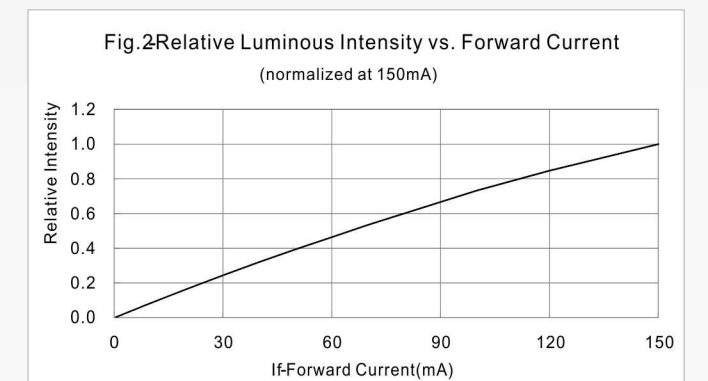
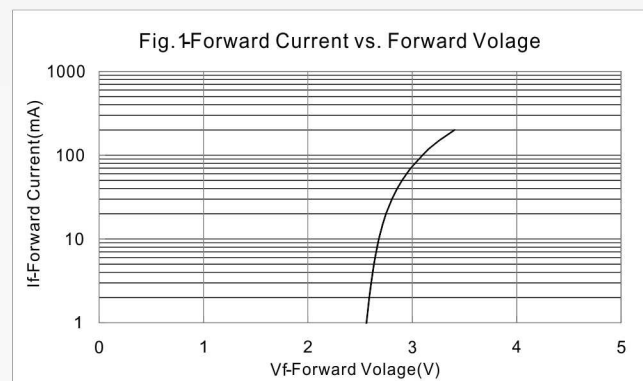
光电参数

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
开启电压	Vf1	If=10μA	2.0	---	2.8	V
工作电压	Vf2	If=150mA	3.0	---	3.6	V
反向漏电流	IR	Vr=5V	---	---	1	μA
主波长	λd	If=150mA	445	---	475	nm
半波宽度	Δλ	If=150mA	---	---	30	nm
光强	Po	If=150mA	110	---	170	mW

参数等级:

Po(mW)	Wd(nm)	447.5-450	450-452.5	452.5-455	455-457.5	457.5-460	460-462.5
160-170	FBKW	GAKW	GBKW	HAKW	HBKW	IAKW	
150-160	FBJW	GAJW	GBJW	HAJW	HBJW	IAIW	
140-150	FBIW	GAIW	GBIW	HAIW	HBIW	IAJW	
130-140	FBHW	GAHW	GBHW	HAHW	HBHW	IAHW	
120-130	FBGW	GAGW	GBGW	HAGW	HBGW	IAGW	

特性曲线



其它说明:

1. 光电参数为采用晶能光电测试仪器在室温下(TA=25℃)测试结果;
2. GaN芯片为静电敏感产品, 请在使用、运输时注意静电保护;
3. 可根据客户要求订做特殊规格芯片;

LatticePower

LatticePower